كنترل ياسخ ديناميكي يوسته استوانهاي ييزوالكتريك مدفون تحت اثر بارگذاری متحرک

هانیه نعیمی کرارودی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران hanyeh.naeimi@gmail.com

سيد محمود هاشمينژاد* استاديار پژوهشکده مواد و انرژی Sm.hasheminejad@gmail.com

تاريخ پذيرش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

چکىدە

در این پژوهش بررسی پاسخ دینامیکی و کنترل ارتعاشات یک پوسته استوانهای پیزوالکتریک ساندویچی مدفون در محيط الاستيك تحت اثر بار حلقهاى متحرك انجام شده است. ابتدا، معادلات ديناميكي پوسته براساس تئوري يوستهي جدار نازك لاو لبه دست آمده و سيس با معادلات حاكم محيط الاستيك اطراف كويله شدهاند. سيس، معادلات دیفرانسیل حاصل با استفاده از تبدیل فوریه حل شده و پس از استفاده از انتگرال عددی گوس برای تبدیل فوریه معکوس، یاسخ دینامیکی حالت یایدار سیستم به دست آمده است. برای کاهش ارتعاشات ناشی از بار متحرک، از کنترل کننده PID با ثوابت بهینهسازی شده استفاده شده است. با تحقیق گسترده انجام شده، نوآوری ارائه شده در این تحقیق کاهش فعال سطح ارتعاشات یک پوسته (لوله، تونل) مدفون هوشمند تحت اثر یک بارگذاری کاربردی متحرک است؛ به نحوی که این نوآوری در همزمانی مدفون بودن در محیط الاستیک نامحدود و پیزوالکتریک بودن یوسته است. نتایج نشان میدهد که کنترلکننده پیادهسازی شده قادر به کاهش دامنهی جابهجایی و تنش در سیستم است. همچنین، عملکرد لایه ی فعال پیزوالکتریک بر مبنای کنترلر مناسب، حساسیت سیستم به تغییرات پارامتری را کاهش میدهد.

واژگان کلیدی: کنترل فعال یاسخ دینامیکی، یوسته استوانهای پیزوالکتریک مدفون، بار حلقهای متحرک، کنترل کننده PID

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

مقاله يژوهشي

۱. مقدمه

پوسته در حالت کلی نام سازهای است که به فضای محصور بین دو رویه اطلاق می شود که در آن بعد ضخامت نسبت به سایر ابعاد بسیار کوچکتر در نظر گرفته می شود [۱] در حقیقت پوسته را می توان در قالب یک رویه میانی که از دو سمت امتداد یافته است در نظر گرفت[۲]. به موجب ویژگیهای خاص مانند تحمل بار بالا نسبت به ابعاد، پوستهها کاربردهای گوناگونی در زمینههای مختلف مهندسی مکانیک، هوافضا، ساختمان، خودرو و غیره دارند. از سوی دیگر در علم مکانیک پوستهی مدفون اصطلاحاً به اُن دسته از پوسته هایی اطلاق می شود که درون محیطی خارجی به دلایل مختلفی تعبیه شده و به آنها اضافه شده یا چسبیدهاند. انواع مختلف تونلها و سازههای مدفون در خاک، پوستههای به کار رفته در سیستمهای خنککاری و پوستههای کامپوزیتی را میتوان از این دسته به حساب آورد. دستهی مهم دیگری از پوستهها شامل پوستههای پیزوالکتریک هستند که در زمره ساختارهای هوشمند قرار می گیرند. ساختار داخلی مواد پيزوالكتريك اين امكان را فراهم مىسازد تا تنش مکانیکی تبدیل به میدان الکتریکی شود و عکس آن اتفاق بیافتد. که نحوهی اتفاق افتادن این روند باعث به وجود آمدن حسگر و عملگر پيزوالکتريک مي شود. يک نکته مهم در مدلسازی پوسته ها نحوه بارگذاری و نوع بار وارد بر أن هاست. یکی از انواع این بارگذاریها، با عنوان بار متحرک، در مطالعه رفتار دینامیکی پوستهها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نیروهای انفجاری و شوک درون لولهها، وسایل نقلیه روی پلها و ریلها، جرثقیلهای سقفی متحرک و غیره از انواع بارهای متحرک محسوب می شوند. بارهای متحرک به علت خاصیت پویا و متغیر با زمان خود و همچنین اثرات ارتعاشی و رزوناسی که به سازهها وارد میسازند اهمیت

خاصی دارند. مطالعات لاو، که مبنای اصلی این پژوهش نیز است، را می توان به عنوان یکی از اولین و پایه ای -ترین پژوهشها در مورد پوستهها دانست. لاو[۳] در مقالهای که در سال ۱۸۸۸ میلادی منتشر کرده است تئوری جامعی در مورد پوستهها ارائه داد و معادلات ارتعاشی پوستههای جدار نازک را بر مبنای فرضیات لاو-کیرشهف استخراج نمود. در زمینه متحرک می-توان از پژوهش پایتون[۴] نام برد که در آن تنشهای وارده بر پوستهی استوانهای الاستیک با طول بینهایت تحت بار متحرک مور مطالعه قرار گرفتهاست. روزنه وباز[۵] پاسخ دینامیکی حالت پایدار پوستهای استونهای تحت بار متحرک نقطه ای را با استفاده از تئوری دانل-مشترى و تحليل المان محدود بررسى كردند. ژانگ و همکاران[۶] در سال ۲۰۱۴ به بررسی سرعت بحرانی بار متحرک اعمال شده بر پوستهای استوانهای با طول بینهایت با استفاده از تئوری لاو پرداختند. سویونگ و سئوک[۷] پوستهی استوانهای تحت بارگذاری دوگانهی اعمال شده از سطح داخلی را، با استفاده از قانون هوک و روش جداسازی متغیر و روش فروبینیوس[†]، تحلیل نمودند و با استفاده از شرایط تعامد دوگانه معادله گسسته شده برای هر حالت را به دست آوردند. با استفاده از جوابهای معادلات گسسته شده سرعت بحرانی برای نيروى متحرک دوگانه بررسى شده است. أرازم و ایپاکچی[۸] به بررسی پاسخ ارتعاشی پوسته استوانه -ای مدرج تابعی با طول مشخص تحت اثر بار فشاری داخلی متحرک پرداخته و نتایج حل نیمه تحلیلی را با روش المان محدود مقایسه کردهاند و نشان دادهاند که پارامتر نسبت طول به شعاع مقطع و فرکانس طبیعی و همچنین سرعت بحرانی و پارامتر نسبت شعاع بر ضخامت پوسته نسبت عکس با یکدیگر دارند. ایپاکچی و همکاران[۹] مقالهای به منظور بررسی پاسخ دینامیکی پوسته استوانهای ویسکوالاستیک تحت اثر بار فشاری

نشريهٔ علمی صوت وارتعاش / سال دوازدهم / شمارهٔ بیست و چهار / ۲۰۰۴/ سید محمود هاشمی نژاد

بايوت مدل مىشود. الزبيعى[١٧] پژوهشى مبتنى بر تحلیل المان محدود پیشرفته و یادگیری ماشین حول بهبود روشهای طراحی لولههای مدفون صلب (بتنی) و ارائه داده است. اکبرف و مهدیف در مجموعهای از مقالات[۱۸, ۱۹] در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به بررسی پاسخ دینامیکی پوستهی استونهای با شرایط و روش-های مختلف حل معادلات پرداختهاند. تانگ و همکاران[۲۰] تأثیر بار حلقهای متحرک به پوستهی استوانهای مدفون در بستر پروالاستیک با استفاده از تئوری بایوت غیرمحلی را بررسی کردهاند. اثر پارامتر غیرمحلی بر فشار منافذ بستر پروالاستیک آنالیز شده که نشان میدهد پارامتر غیرمحلی، بیشینه فشار منفذی محیط متخلخل را افزایش میدهد. در مقالهای که لیو و همکارانش[۲۱] منتشر کردند تأثیر پارامترهای بستر وینکلر-پاسترناک'' بر روی رزونانس داخلی غیرخطی پوستههای جدار نازک متخلخل مورد ارزیابی قرار داده شدهاند. على بيگلو و طالبي توتي[۲۲] به بررسي پاسخ گذرای سهبعدی و ترموالاستیسیتهی کوپل شدهی پوستهی مدرج تابعی جاسازیشده در لایههای پیزوالکتریک با تکیه گاه ساده با استفاده از تئوری لرد-شولمان^{۱۲} پرداخته و نشان دادند که ناهمگنی ماده به طور قابلتوجهی بر رفتار ترموالاستیک جفتشده سیستم تأثیر می گذارد. گیرنیس و همکاران[۲۳] به بررسی تأثیر بار متحرک بر پوستهی دولایهی مدفون در محيط الاستيک پرداختند. در اين مطالعه بر تأثير لایهی بیرونی پوسته بر سرعت بحرانی تمرکز شده است. نتایج این مطالعه نشان داد ضخامت و پارامترهای لایهها بر سرعت بحرانی و میزان تنش و کرنش وارده تأثیر گذار است. پژوهش سینق و همکاران[۲۴] در سال ۱۹۸۸ مطالعهای مشابه پژوهش چونان[۱۳] را برای پوسته جدار نازک پیزوالکتریک، تحت بارگذاری محوری و جانبی، انجام داد. ساویز و همکاران[۲۵] به

منتشر کرده که رفتار پوسته نسبت به نیروی برشی ويسكولاستيك فرض شده است. سرعت بحراني و فرکانس طبیعی سیستم در این پژوهش بررسی شده است. هیو و همکاران[۱۰] ارتعاشات تصادفی یک پوستهی ارتوتروپیک جدار نازک در شرایط پایدار و ناپایدار را با روش تحلیلی گسسته^۵ بررسی کردند. سعیدی و همکاران[۱۱] مقالهای در مورد بررسی رفتار ترموالاستوپلاستیک پوستهی استوانهای مدزج تابعی جدار ضخیم منتشر کردند. در این پژوهش با استفاده از روش تقریبهای متوالی² پاسخ پوسته که تحت فشار داخلی و گرادیانهای دمایی میباشد، بررسی شده است. در پژوهش گائو[۱۲] سرعت بحرانی پوستهی دو لایه اتصال کامل^۷ تحت بارگذاری فشاری متحرک با درنظر گرفتن اینرسی چرخشی و ناهمگنی بررسی شد. چونان[۱۳] در مطالعهی خود به بررسی اثر بار متحرک بر ارتعاشات پوستهی جدار نازک مدفون در محیط الاستيك پرداخت. براي مدلسازي محيط الاستيك نيز از تئوري الاستیسیته استفاده کرد. دوویدی و سینق[۱۴] پژوهشی را که حول لولههای حاوی سیال مدفون نامتقارن تحت اثر بارگذاری محوری متحرک انجام شده، ارائه دادهاند. هاشمینژاد و کمیلی[۱۵] با استفاده از معادلهی کلاسیک ناویر^۸ و تئوری پوستهی جدار ضخیم، پوستهای با طول بینهایت را که در بستر پروالاستیک مدفون بوده و تحت بارگذاری حلقهای متحرك است، تحليل كردند. پاسخ سيستم با استفاده از تبدیل فوریه و حل عددی به دست آمده است. محیط پروالاستیک نیز با استفاده از تئوری بایوت^۰ مدلسازی شد. یوآن و همکاران[۱۶] در تحقیقی پاسخ دینامیکی یک تونل مدفون در یک لایه خاک متخلخل دو بعدی در معرض بار نقطه متحرک را مورد بررسی قرار دادند. تونل به عنوان یک تیر طویل اویلر-برنولی^{۱۰} مدلسازی شد. محيط پروالاستيک اشباع نيز با استفاده از تئوري کامپوزیتی پیزوالکتریک را تحت فشار و بار الکتریکی بررسی می کنند. تحلیل مساله به صورت سه بعدی و با استفاده از روش اجزا محدود صورت گرفته است. لی[۳۲] مقالهای حول موضوع ارتعاش فعال پرهی توربین بادی دارای سنسورهای پیزوالکتریک منتشر کرده است. مدل یک تیغه مرکب لایهای است و لایههای پیزوالکتریک جاسازیشده در سطوح بالا و پایین به عنوان سنسور و محرک عمل می کنند. برای پایین به عنوان سنسور و محرک عمل می کنند. برای نیرل ارتعاش از الگوریتم کنترل بازخورد سرعت منفی با بهره ثابت استفاده شده است. کنترل ارتعاشات غیرخطی پوستههای استوانهای لایهای با لایه پیزوالکتریک ناپیوسته توسط لی و همکاران[۳۳] مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مبحث علاوه بر مقالات ذکر شده می توان به مراجعی اشاره کرد که شامل مطالعات کاربردی تری هستند. جنبههای مختلف مسئله مانند پوستهی استوانهای، پوسته ی پیزوالکتریک، بار متحرک و مدفون بودن و تركيب آنها موضوع اين مقالات هستند. از جمله نمونههای کاربردی می توان به نانو لولهها، تونلهای مدفون، خطوط لولهی انتقال سیالات، لولههای کامپوزیتی و... اشاره نمود. لازم به ذکر است که بار متحرک نیز مدل شده از نیروهای سیالات درون لوله و یا حرکت یک جسم درون تونل میتواند باشد. در بررسی کاربردی تر می توان به مقاله ی ببن و آکاریا [۳۴] و همکاران که در مورد دینامیک مجراهای آب مدفون انجام شدهاند، اشاره کرد. در این مقاله نشان داده شده است که بارهای ترافیکی متحرک، جابهجایی بیشتری را در مجراهای مدفون در مقایسه با بارهای ترافیکی ساکن ایجاد می کنند. فارست و هانت[۳۵] در مقالهای تحلیل سه بعدی ارتعاش ایجاد شده در زمین و تونل از طرف قطار زیرزمینی، که مدل شدهی همان بار متحرک وارد شده بر پوستهی استوانهای با طول بینهایت است،

بررسي پاسخ سه بعدي الاستيسيته پوستهي استوانهاي پیزوالکتریک با بارگذاری دینامیک پرداختند. در این تحلیل پوسته تحت انواع بارگذاری قرارگرفته و معادلات سیستم با استفاده از بسط مثلثاتی ساده شده است.ازمطالعات کنترلی مرتبط با پوستههای پیزوالکتریک، می توان از مقاله ی ژانگ و همکاران[۲۶] ، که کنترل ارتعاش پوسته ی استوانه ای پیزوالکتریک با تکیه گاه ساده را تحلیل کردند، نام برد. نتایج حاصل از شبيهسازى نشان مىدهد كه با ولتاژ كنترلى يكسان، عملگر پیزوالکتریک با تعداد لایههای مختلف می تواند عملکرد کنترلی بهتری نسبت به عملگر پیزوالکتریک تک لایهای مرسوم داشته باشد و ارتعاش شعاعی پوسته به طور قابل توجهی کاهش می یابد. شنگ و وانگ[۲۷] با استناد بر معادلات جابهجایی تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی و به کمک اصل همیلتون و معادله ی ماکسول پاسخ دینامیکی پوستهی مدرج تابعی پیزوالکتریک^{۳۲} ، با پارامترهای وابسته به دما، تحت بارگذاری متحرک را بررسی کردند. ژانگ و همکاران[۲۸] نیز به تحقیق در مورد کنترل ارتعاشات سازهی هوشمند پیزوالکتریک با استفاده از کنترلکننده ۲۱ PID پرداختند. این تحقیق برای سازههای جدار ۱۴ نازک انجام شده است. عارفی و همکاران[۲۹] در سال ۲۰۱۶ پژوهشی در خصوص بررسی پاسخ ارتعاش آزاد پوستهی استوانهای مدرج تابعی ترکیب شده با لایهی پیزوالکتریک انجام دادند. در این پژوهش از روش تنش برشی مرتبهی اول^۵ و اصل همیلتون^۱ و معادلهی ناویر معادلات سیستم استخراج شده است. در انتها نیز نتایج بدست آمده از حل عددی ارائه شده است. ژو و همکاران[۳۰] پاسخ دینامیکی پوستهی استوانهای پیزوالکتریک را تحت اعمال بار ضربه ی با استفاده از روش ماتریس موج-انعکاس^{۱۷} به دست آوردند. لیو و همکاران[۳۱] تغییر شکل پوستهی استوانهای

را ارائه دادند. در این مقاله بررسی با تئوری پوستههای جدار نازک و اعمال تبدیل فوریه بر هر دو پارامتر مکان و زمان و در نظر گرفتن زمین به عنوان بستر الاستیک انجام شده است. مقالهی رحیمی و همکاران[۳۶] نیز به تحلیل ارتعاش پوستهی پیزوالکتریک مدرج تابعی چرخان که تحت اثر بارهای مکانیکی، الکتریکی و دمایی درونی است، میپردازد. همچنین میتوان از مقالهی محمدی و همکاران[۳۷] نام برد که در مورد نانو لولههای مدرج تابعی مدفون در بستر پسترناک است.

در مطالعهی حاضر هدف آن است که در ابتدا رفتار دینامیکی پوستهی پیزوالکتریک استوانهای مدفون با طول بینهایت که تحت اثر بارگذاری متحرک است مدل-سازی شود و در گام بعد کنترل کنندهی بهینهای به منظور کنترل أن طراحي گردد. اين مدلسازي را مي-توان نمونهای از یک لولهی پیزوالکتریک که در محیطی با جنس دارای ویژگیهای الاستیک مدفون مى باشد، دانست. قابل ذكر است كه نوآورى اين پژوهش در بررسی ارتعاش پوسته ی طویل پیزوالکتریک مدفون در محیط نامحدود الاستیک است؛ به طوری که احاطه شدن پوستهی پیزوالکتریک در مقالات دیگر عمدتاً به معنای محاط شدن لایههای پوسته میباشد اما در این مقاله مدفون بودن پوسته ی پیزوالکتریک، از طریق ادغام روش دو مقاله ی مرجع [۱۲و۳]، در محیط نامحدود بررسی شده است؛ استفاده از کنترل کننده پی آی دی به دلایل سادگی، تأثیر بالا و سهولت بکارگیری در کاربردهای صنعتی میباشد. همچنین، همانگونه که در متون چکیده و آخرین پاراگراف مقدمه نیز تاکید شده است نوآوری اصلی مقاله در کاهش فعال سطح ارتعاشات یک پوسته (لوله، تونل) مدفون هوشمند تحت اثر یک بارگذاری کاربردی متحرک میباشد. کنترل کنندههای PID معمولی به دلیل ساختار خطی

ساده، مقاومت قابل قبول و عملکرد بالا نسبت به هزینه، در طیف وسیعی از شرایط عملیاتی، یکی از پرکاربردترین و کاربردیترین کنترل کنندهها در محیطهای صنعتی هستند [۳۸–۴۱]. همچنین این تحقیق با کنترل ارتعاش پوسته ادامه پیدا می کند. قسمتهای مقاله به این شرح هستند: در قسمت بعد رفتار دینامیکی پوسته مدفون مدل سازی شده و فرضیات مدل سازی مطرح می گردند. در قسمت سوم نتایج بهینه سازی و شبیه سازی ارائه شده و در مورد جزئیات آن ها بحث می شود. در نهایت نیز یک جمع بندی از موارد مطرح شده و نتایج مقاله صورت خواهد گرفت.

۲. مدلسازی

در این مدلسازی از تئوری کلاسیک پوسته ی لاو استفاده می شود؛ لذا همانطور که در پیوست الف شرح داده شده روابط جابه جایی رویه ی میانی در سه راستای و روابط تنش و کرنش به دست می آید. معادلات خطی تنش-کرنش به فرم ماتریسی و روابط الکتریکی بر اساس مراجع[۴۲, ۴۳] نوشته می شوند که در پیوست الف این روند تشریح شده است. در ادامه ی روند دستیابی به معادلات سیستم از اصل هملیتون برای به دست آوردن معادلات دیفرانسیل سیستم استفاده می کنیم.







شکل۱. سیستم مورد بررسی: (الف) مختصات و هندسهی پوسته؛

(ب) برشی از مقطع پوسته

۲-۱. دستگاه معادلات

اصل همیلتون برای اجسام تغییرشکلپذیر به صورت زیر است:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\delta \Pi_k - \left(\delta W_e + \delta \Pi_s \right) \right] dt = 0 \tag{1}$$

با علم بر اینکه در این معادله W_e و \prod_s, W_e و انرژی مجازی نیروهای خارجی، انرژی کرنشی و انرژی مجازی نیروهای خارجی، انرژی کرنشی و انرژی جنبشی سیستم هستند. عبارات دقیق انرژیها نیز در پیوست الف در روند بدست آوردن دستگاه معادلات دیفرانسیل سیستم آورده شده است. در این مسئله با دو دسته نیرو مواجه هستیم. نیروی اول همان نیرو ناشی از بار فشاری حلقه ی متحرک است. این نیرو F_p به شکل زیر قابل محاسبه است:

$$F_{P} = 2\pi \left(r_{c} - h_{2} - h_{p} \right) P_{0} \delta_{d} \left(x - c_{0} t \right)$$

$$\delta W_{e}^{P} = F_{P} \delta x = 2\pi \left(r_{c} - h_{2} - h_{p} \right) P \delta z$$

$$Y)$$

قابل ذکر است که در معادله ی (۲)،
$$P_0$$
 اندازه ی بار فشاری و r_c شعاع و δ_d تابع دلتای دیراک و مطابق با شکل (۱)، r_c شعاع انحناء رویه ی میانی پوسته الاستیک و همینطور $P = P_0 \delta_d \left(x - c_0 t \right)$ بین سطح پوسته و محیط الاستیک دور آن ایجاد

می شود که در شکل زیر نشان داده شده است. این
تماس موجب ایجاد تنش در سطح تماس می شود. این
تنش ها خود ایجاد انرژی می کنند که کار مجازی آن ها
در قالب معادلات پیش رو قابل محاسبه است:
$$\delta W_e^{\sigma_r} = 2\pi (r_c + h_c + h_c) \sigma_r \delta z$$

$$\delta W_e^{\tau} = 2\pi \left(r_c + h_2 + h_p \right) \tau \,\delta x \tag{(7)}$$

$$\begin{split} \delta W_e &= \delta W_e^P + \delta W_e^{\sigma_r} \\ &+ \delta W_e^\tau = 2\pi \Big(r_c - h_2 - h_p \Big) P \, \delta z. \end{split} \tag{4}$$

با توجه به پیوست الف پس از استفاده از فرضیات لاو و نوشتن مؤلفههای انرژی و سپس استفاده از معادلهی همیلتون، معادلات مربوط به متغیرهای جابهجایی عمومی مسئلهی حاضر یعنی $\varphi_s, \varphi_a, w, v, x$ به صورت معادلهی (۵) به دست می آیند.

$$\left(a_{11}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{a_{66}}{r_c^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\right)u + \frac{1}{r_c}\left(a_{12} + a_{66}\right)\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial\theta} + \frac{a_{12}}{r_c}\frac{\partial w}{\partial x}$$
$$+ \left(1 + \frac{h_p + h_2}{r_c}\right)\tau = I_1\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$
$$\frac{1}{r_c}\left(a_{12} + a_{66}\right)\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial\theta} + \left(\frac{a_{22}}{r_c^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + a_{66}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{d_{66}}{r_c^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)$$
$$+ \frac{d_{22}}{r_c^4}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\right)v + \left(\frac{a_{22}}{r_c^2}\frac{\partial}{\partial\theta} - 2\frac{d_{66}}{r_c^2}\frac{\partial^3}{\partial x^2\partial\theta} - \frac{d_{12}}{r_c^2}\frac{\partial^3}{\partial x^2\partial\theta}\right)$$
$$+ -\frac{d_{22}}{r_c^4}\frac{\partial^3}{\partial\theta^3}\right)w + \frac{E_{32}^a}{r_c^2}\frac{\partial \varphi_a}{\partial\theta} + \frac{E_{32}^s}{r_c^2}\frac{\partial \varphi_s}{\partial\theta} = I_1\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$$

نشريهٔ علمی صوت وارتعاش / سال دوازدهم / شمارهٔ بیست و چهار / ۲۰۰۴/ سید محمود هاشمی نژاد

$$\begin{split} -\frac{a_{12}}{r_c}\frac{\partial u}{\partial x} - \left(\frac{a_{22}}{r_c^2}\frac{\partial}{\partial \theta} - 2\frac{d_{66}}{r_c^2}\frac{\partial^3}{\partial x^2\partial \theta} - \frac{d_{12}}{r_c^2}\frac{\partial^3}{\partial x^2\partial \theta} - \frac{d_{12}}{r_c^2}\frac{\partial^3}{\partial x^2\partial \theta} \right) \\ -\frac{d_{22}}{r_c^4}\frac{\partial^3}{\partial \theta^3} \right) v - \left(d_{11}\frac{\partial^4}{\partial x^4} - 2\frac{d_{12}}{r_c^2}\frac{\partial^4}{\partial x^2\partial \theta^2} + \frac{d_{22}}{\partial x^2\partial \theta^2} \right) \\ + 4\frac{d_{66}}{r_c^2}\frac{\partial^4}{\partial x^2\partial \theta^2} + \frac{d_{22}}{r_c^2}\frac{\partial^4}{\partial \theta^4} + \frac{a_{22}}{r_c^2} \right) w \\ + \left(E_{31}^a\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{E_{31}^a}{r_c^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\right) \varphi_a + \left(E_{31}^s\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{E_{31}^s}{r_c^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\right) \varphi_s \\ + q_a + \left(1 + \frac{h_p + h_2}{r_c}\right) \sigma_r + \left(1 - \frac{h_p + h_2}{r_c}\right) P = I_1\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \\ \left(X_{11}^a\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{X_{32}^a}{r_c^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} - X_{33}^a\right) \varphi_a + \frac{E_{32}^a}{r_c^2}\frac{\partial v}{\partial \theta} \\ - \left(E_{31}^a\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{E_{32}^a}{r_c^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\right) w = 0 \\ \left(X_{11}^s\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{X_{32}^s}{r_c^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} - X_{33}^s\right) \varphi_s + \frac{E_{32}^s}{r_c^2}\frac{\partial v}{\partial \theta} \\ - \left(E_{31}^s\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{E_{32}^s}{r_c^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\right) w = 0 \end{split}$$

$$(\Delta)$$

ذکر است که در معادلات حاضر
$$q_a$$
 قسمت الکتریکی
ولتاژ اعمالی در طول لایه عملگر است که برابر است
با [۴۲]:

$$q_{a} = \frac{2}{h_{p}} \int_{-h_{p}-h_{2}}^{-h_{2}} \left(z + \frac{2h_{2}+h_{p}}{2} \right) V_{a} dz$$
 (8)

به طوری که V_a ولتاژ اعمالی عملگر پیزوالکتریک که از q_a طرف کنترل کننده به آن اعمال می شود، می باشد و با انتگرال گیری از این پارامتر در طول لایهی عملگر و با درنظرگرفتن ضخامت این لایه محاسبه می شود. ضرایب به کار رفته در معادلات فوق نیز در پیوست الف ذکر شده است. این معادلات دیفرانسیل رفتار سیستم را به شکل کلی بیان میکنند. از آنجایی که در مسألهی

حاضر در راستای heta هیچ عاملی برای ایجاد حرکت وجود ندارد و بار وارد شده نیز حلقهای متقارن است، تمامی مشتقات نسبت به این راستا و مؤلفه ی جابه جایی v حذف می شوند.

۲-۲. اعمال شرایط مرزی

در این مرحله نکتهای که باقی میماند محاسبهی تنشهای سطحى در ناحيه ي تماس پوسته و محيط الاستيک است. براى اين كار بايد رفتار محيط الاستيك مدلسازی شود. به این منظور از نظریهی خطی الاستيسته استفاده شده است. معادلات مذكور برگرفته از مرجع[۱۳] است. همچنین با به کارگیری دو تابع پتانسیل $\chi(x,z,t)$ و $\psi(x,z,t)$ جابهجایی محیط الاستيك به اين صورت قابل محاسبه است: aw ar

$$u_{2}(x,z,t) = \frac{\partial \psi}{\partial z} - \frac{\partial \chi}{\partial x}$$
$$w_{2}(x,z,t) = \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \chi}{\partial z} + \frac{\chi}{z}$$
(Y)

برای تخمین فرم کلی توابع پتانسیل، این توابع باید معادلات زير را ارضا كنند:

$$\frac{\partial^{2}\psi}{\partial z^{2}} + \frac{1}{z}\frac{\partial\psi}{\partial z} + \frac{\partial^{2}\psi}{\partial x^{2}} = \frac{1}{c_{l}^{2}}\frac{\partial^{2}\psi}{\partial t^{2}}$$

$$\frac{\partial^{2}\chi}{\partial z^{2}} + \frac{1}{z}\frac{\partial\chi}{\partial z} + \frac{\partial^{2}\chi}{\partial x^{2}} - \frac{\chi}{z^{2}} = \frac{1}{c_{s}^{2}}\frac{\partial^{2}\chi}{\partial t^{2}} \qquad (\Lambda)$$

$$c_{\ell} \neq |_{\Sigma_{s}} \geq \delta_{L}$$

$$c_s^2 = \frac{G_2}{\rho_2}$$
 $c_l^2 = \frac{2G_2(1-v_2)}{\rho_2(1-2v_2)}$ (9)

در معادلات فوق G_2 مدول برشی است و زیروند ۲ به محیط الاستیک دور پوسته اشاره دارد. همچنین $c_s = c_s$ بیانگر سرعت امواج اتساعى و اعوجاجى در محيط الاستيك هستند. از سوی دیگر عناصر تنش براساس روابط الاستيسيته به صورتي كه در پيوست الف آورده شدهاند. درنظر گرفته می شوند. سپس فرض می شود که پوسته و محيط الاستيك توسط پيوندى نازك، الاستيك و بدون جرم با یکدیگر دارای اتصال کامل در راستای شعاعی

نشريهٔ علمی صوت و ارتعاش / سال دوازدهم / شمارهٔ پیست و چهار /۲۰۰۲ / سید محمود هاشمی نژاد

هستند (که این شرایط با تغییر γ_n متفاوت می شود و همچنین با توجه به γ_c درنظر گرفته شده اتصال محوری پوسته و محیط از اتصال محوری دارای لغزش در $0 = \gamma_c$ تا اتصال کامل در $\infty = \gamma_c$ متغیر خواهد بود). این فرض منتج به اعمال شرط مرزی پوسته یا همان برابری تنشهای سطحی پوسته و تنشهای محیط الاستیک در سطح تماس با پوسته خواهد شد. با برابر قرار دادن عبارات تنش پوسته و محیط الاستیک معادلات زیر بدست خواهند آمد:

$$\sigma_{2}(x,z,t)\Big|_{z=h_{2}+h_{p}} = \sigma(x,t)$$
$$= \left(k_{n} + \eta_{n}\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(w_{2}\Big|_{z=h_{2}+h_{p}} - w\right)$$

$$\tau_{2}(x,z,t)\Big|_{z=h_{2}+h_{p}} = \tau(x,t)$$
$$= \left(k_{s} + \eta_{s}\frac{\partial}{\partial t}\right)\left\{u_{2}\Big|_{z=h_{2}+h_{p}} - \left[u + (h_{2} + h_{p})\frac{\partial w}{\partial x}\right]\right\}$$

$$(\mathbf{)} \cdot \mathbf{)}$$

لازم به ذکر است که طبق این مدل سازی از لایه ی اتصال
پوسته و محیط الاستیک، پارامترهای
$$k_s$$
 و n_s نشان –
دهنده ی سختی پیوند در راستاهای برشی و نرمال
هستند که بین صفر تا بی نهایت در تغییرند. (همچنین
در این پژوهش از اثر میرایی این اتصال که با
در این پژوهش از اثر میرایی این اتصال که با
پارامترهای η_s و η_r طبق مرجع[۱۳] مدل سازی
شدهاند، صرف نظر شده و مقدار صفر را به خود
اختصاص می دهند.)

۲-۳. روش حل

با توجه به این که طول سیستم بینهایت در نظر گرفته شده است، زمانی که سیستم به حالت ماندگار خود میرسد، تغییر شکل پوسته نسبت به دستگاه مختصاتی که هر لحظه بار متحرک را تعقیب مینماید ثابت خواهد بود. در این شرایط میتوان از تبدیل فوریه و

تبدیل معکوس فوریه برای حل معادلات و دستیابی به پاسخ سیستم استفاده نمود. با استفاده از این تبدیل معادلات دیفرانسیل سیستم به معادلات جبری تبدیل شده و فرآیند حل بسیار سادهتر خواهد بود.[۴۴] در سیستم حاضر از مختصات متحرک برای این تبدیل استفاده میکنیم. در این حللت برای تبدیل فوریه و تبدیل معکوس فوریه (از حوزه فرکانس به حوزه زمان و مکان) داریم:

$$\overline{f}(z,\xi,\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(z,x,t) e^{-i(\xi z + \omega t)} dt dz$$
$$f(z,x,t) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f}(z,\xi,\omega) e^{i(\xi z + \omega t)} d\xi d\omega$$
(1))

با فرض بر آن که در عبارات بالا ω و z متغیرهای مستقل در حوزه فرکانس و به ترتیب متغیرهای تبدیل نظیر زمان t و مکان x هستند. شایان ذکر است که به دلیل حضور ترم $\delta_a(x-c_0t)$ محادلات حوزه مکان-زمان عبارت نظیر $\delta_a(x+c_0z)$ ه در حوزه فرکانس ایجاد می شود. در این حالت رابطهی فرکانس ایجاد می شود. در این حالت رابطهی ماندگار می توانیم از تبدیل معکوس فوریه زیر استفاده کنیم[۵۴, ۲۶]:

$$f(z,t) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f_2}(z,\xi,-c_0\xi) e^{i\xi z} d\xi \qquad (17)$$
 لازم به ذکر است که در معادله ی بالا تساوی $\overline{f}(z,\xi,\omega) = \delta_d(\omega+c_0\xi).\overline{f_2}(z,\xi,\omega)$ برقرار میادلات تبدیل فوریه، میباشد. حال با استفاده از معادلات تبدیل فوریه، معادلات دیفرانسیل سیستم را به حوزه فرکانسی معادلات می میادلات میادلات مربوط به فضای فرکانسی نگاشت می کنیم. معادلات مربوط به فضای فرکانسی در پیوست الف آورده شدهاند. لازم به ذکر است برای حل عددی تبدیل معکوس فوریه از روش انتگرال گوسی استفاده می شود.

درنهایت با اضافه شدن دو معادلهی بستر الاستیک تعداد
معادلات سیستم به عدد هفت می سد و معادلات
جبری خواهیم داشت که می توان به صورت ماتریسی
$$\widehat{\mathbf{A}} \mathbf{X} = \widehat{\mathbf{B}}$$
 آن را نشان داد به صورتی که بردار X،
بردار مجهولات دستگاه معادلات، $\widehat{\mathbf{A}}$ ماتریس ضرایب
و $\widehat{\mathbf{B}}$ بردار نیروهای عمومی است.
۲-3. پیاده سازی کنترل کننده

سازه پس از رسیدن به پاسخ دینامیکی سیستم، با توجه به استفاده از لایه پیزوالکتریک در پوسته، برای روند کنترل ارتعاشات در نظر گرفته شده است که با اندازه – گیری جابهجایی لایه میانی توسط لایه ی سنسور پیزوالکتریک و با ایجاد تغییر ولتاژ لایههای پیزوالکتریک منجر به ایجاد جابهجایی این لایهها و در نتیجه ایجاد اثر خنثی بر جابهجایی اندازه گیری شده فرآیند کنترل صورت گیرد و لذا با توجه به توضیح بالا فرمان کنترلی مربوط به ولتاژ سنسور خواهد بود که به صورت بهره K_0 می شود. بنابراین:

$$V_a = -K_0 V_s \tag{17}$$

$$V_s = R_L I_s(t)$$
 در حالی که ولتاژ سنسور مدار باز به صورت R_L مقاومت مدار،
خواهد بود. به طوری که در آن R_L مقاومت مدار،
 $= dQ(t)/dt$ بریان خروجی از سنسور می
باشد و بر اساس عبارت شار الکتریکی
 $Q(t) = \int_{h_2}^{h_p+h_2} \int_0^{2\pi} \{D_z\}_s r_{ex} d\theta dz$
همچنین میدانیم $P_{ex} = r_c + h_p + h_2$ بدست میآید.
همچنین میدانیم در جهت Z ، میدان الکتریکی در
فرض قطبی شدن در جهت Z ، میدان الکتریکی در
لایه سنسور پیزوالکتریک همانطور که در معادلات
پیوست الف اشاره شد، به صورت رابطه ازیر بیان می
شود.[۴۷, ۴۳]

$$\{D_z\}_s = e_{31} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - z \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right) + e_{32} \left[\frac{1}{r_c} \left(\frac{\partial v}{\partial \theta} + w\right) - \frac{z}{r_c^2} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2} - \frac{\partial v}{\partial \theta}\right)\right] - \mu_{33} \left(\frac{\pi}{h_p}\right) \sin\left[\frac{\pi}{h_p} \left(z - \frac{2h_2 + h_p}{2}\right)\right] \varphi_s$$
(14)

با توجه به عبارت بالا خواهيم يافت كه با اعمال تبديل فوريه بر آن، مجموعی از ضرایب پارامترهای مجهول سیستم است پس عبارت بالا را به معادلات قبل اضافه کرده و پس از اعمال تبدیلها و درنظرگرفتن ولتاژهای اعمالی و سادهسازی یک معادلهی جبری جدید خواهیم داشت. در این پژوهش از کنترل کننده PID استفاده شده است. از آنجایی که میدانیم تابع کنترلی اعمالی برای كنترل كننده به صورت نوع اين تعريف مى شود. براى $K_P + \int K_I dt + K_D dt$ استفادهی آن در فضای معادلات خود با گرفتن تبدیل فوریه نسبت به زمان عبارت مربوط به آن به صورت در می آید. لازم به ذکر $K_P + K_I / i\omega + K_D . i\omega$ است که i ضریب واحد موهومی میباشد. لذا عبارت بدست آمده جای ضریب K_0 در معادلهی (۱۳) نشسته و ضرایب کنترلی K_P, K_I, K_D در معادله جای خواهند گرفت.

$$V_a(s) = (K_P + K_I / i\omega + K_D i\omega)V_s(s) \qquad (1\Delta)$$

به طوری که ω پارامتر فرکانسی تبدیل یافته ی زمان است و با توجه به فرض محاسباتی پروژه خود ضریبی از پارامتر فرکانسی *s* است، صحت عبارت بالا را به دنبال خواهد داشت. با ارجاع به منبع[۱۳] از آنجایی که بین ω و ξ رابطه ی ξ و *s* منبع[۱۳] حسن پس با توجه به رابطه ی ξ و *s* پس $2h_2 - c_0 s - c_0 s$ خواهد بود.

به منظور بهینهسازی مقادیر ضرایب کنترل کننده از الگوریتم بهینهسازی ژنتیک چندهدفه استفاده شد. دو تابع هدف برای تعیین درست ضرایب مطلوب در نظر گرفته شده نشريهٔ علمی صوت و ارتعاش / سال دوازدهم / شمارهٔ بیست و چهار /۲۰۰۲ / سید محمود هاشمی نژاد

است که به ترتیب عبارتاند از میزان انتگرال قدرمطلق خطا^{۱۸} ی جابهجایی شعاعی پوسته و میزان انتگرال قدرمطلق ولتاژ اعمالي به لايهي عملگر. البته هر دو اين مقادیر به صورت بیبعد مورد بررسی قرار می گیرند.

۳. نتايج

نتایج حاصله از قسمت روش حل که در نرمافزارهای متمتیکا^{۱۹} و متلب انجام شده است را در این قسمت بررسی می کنیم. در ابتدا نتایج شبیه سازی های اولیه با مراجع اصلى مقايسه مى شود تا صحت روش حل مورد تأييد قرار بگيرد. نتايج اوليه شامل جابهجايي شعاعي پوسته مدفون، بدون درنظر گرفتن لايه ی پيزوالکتريک، و فرکانسهای طبیعی اصلی سیستم غیرمدفون است که به ترتیب با مراجع[۴۲, ۴۳, ۴۸, ۴۹] مقایسه می شوند. مشخصات سیستم مورد بررسی به شرح زیر است. طول پوسته بینهایت در نظر گرفته شده است. مقادیر عددی پارامترها در جدول(۱) ذکر شدهاند. به صورتی که لایه ی پیزوالکتریک از PZT4 و لایه ی الاستيك پوسته از جنس آلوميينيوم خواهد بود. شايان ذكر است كه در این قسمت جابهجایی، ولتاژ و موقعیت بیبعد مورد بررسی قرار گرفتهاند که به صورت زیر تعريف مي شوند:

$$w^{*} = \left(\frac{E_{s}}{\left(1 - v_{s}^{2}\right)r_{c}P_{0}}\right)w \qquad V^{*} = \frac{V}{\sqrt{P_{0}c_{0}R}}$$
$$\sigma_{\theta\theta}^{*} = \frac{\sigma_{\theta\theta}}{P_{0}} \qquad x^{*} = \frac{\overline{x}}{h_{s}} \qquad \overline{x} = x - c_{0}t \qquad (18)$$

پارامتر	مقدار	پارامتر	مقدار
Ε	$\forall \cdot MPa$	E_2 / E	•.170
ρ	$\mathbf{v}\mathbf{v}\mathbf{\cdot}\mathbf{\cdot}\mathbf{K}\mathbf{g}/m^3$	$ u_2 $	۳۳. ۰
\mathcal{U}_s	۸۲. ۰	λ	۰.۲۵
r_c	$\cdot .) m$	λ_l	۰.۷۲
h_s / r_c	١/٢٠	$\lambda_{_s}$	۰.۳۶۳

برای صحت سنجی و برای حذف اثر لایهی پیزوالکتریک $h_{p} = |\bullet|$ ضخامت آن را به سمت صفر میل می دهیم). نتایج به دست آمده در قالب شکل (۲) و شکل (۳) به نمایش درآمده است. نمودارها پس از بیبعدسازی پارامترهای جابهجایی، ولتاژ و موقعیت به صورت زیر



 $\lambda = 1/10$ چونان[۱۳] برای سرعت بی بعد $\lambda = 1/10$ همانگونه که در نمودار مشخص است نتایج شبیهسازی فعلی تطابق مطلوبي با نتايج مرجع داشته كه نشان دهنده اين مسأله است که شبیهسازی پوستهی مدفون به شکل درستی صورت پذیرفته است. بیشترین اختلاف بین دادههای بین نتایج پژوهش حاضر با نتایج موجود در مرجع برای نمونهی ۰/۰۱ همان گونه که انتظار می رود با فاصله گرفتن از محل اعمال بار میزان جابهجایی نیز كمتر مىشود. شيب كاهش جابهجايي ابتدا زيادتر بوده و به مرور کاهش می یابد و به صفر می سد. برای مقادیر پايين سختي برشي اتصال بين خاک و پوسته (γ_s) روند تغييرات جابهجایی شدت بیشتری دارد. نکته قابل توجه آن است که در حدود طول سه برابر ضخامت پوسته (۳ شيب تغييرات جابهجايي روندي كاهشي به خود ($x^* pprox$

179

می گیرد و این ناحیه، نقطه عطف سیستم محسوب می شود. نمودار جابه جایی نقطه اعمال بار بر اساس نسبت سرعت بار، نیز با نتایج مرجع مذکور مورد مقایسه گرفت که در ادامه به نمایش در آمده است:



مقالهي چونان[۱۳]

آنچه که در این قسمت نیز مشهود است تطابق مطلوب نتایج پژوهش حاضر با مرجع است. بیشترین تفاوت نتایج برای مقادیر λ نزدیک به صفر و حدود ۵ درصد است. با افزایش مقدار λ اختلاف نتایج کمتر شده و به سمت صفر میل می کند. در خصوص روند نتایج نیز با توجه به آنچه مشهود است می توان گفت که افزایش سرعت بار متحرک به افزایش دامنه جابهجایی می شود؛ به نحوی که تابع جابهجایی بر حسب سرعت اکیداً صعودی است. مقدار و شیب افزایش جابهجایی در سیستمهایی با سختی برشی کمتر، بیشتر است. در ادامه به منظور صحتسنجی شبیهسازی پوستهی پیروالکتریک، فرکانسهای طبیعی آن مراجع[۴۲, ۴۳] مقایسه می شود. شایان ذکر است که به منظور محاسبه فرکانس طبيعي سيستم از روش و پارامترهاي عددي به كار رفته در مرجع[۴۳] استفاده شده است. همچنین مشابه مرجع[۴۲] سیستم به نحوی در نظر گرفته شده است که در آن فقط لایه عملگر تعبیه شده و از لایه سنسور

صرف نظر می شود. نتایج بررسی نیز شامل فرکانس طبیعی بی بعد است که به ترتیب با مراجع[۴۲, ۴۳, ۴۸, ۴۹] مقایسه می شوند.:

جدول۲. فركانس های طبیعی پوسته پیزوالكتریک

n	خیبری و بنی	لیائو لیانگ ک و همکاران [۴۳]	وانگ و همکاران	هاشمینژاد و جمال - یور	fc F-
	[44]		[49]	[47]	٣٨
۱	•/•1981	./.19.1	./.1918	./.19198	
۲	•/•1181	./٩٣٨	•/•1••9	•/••9399	٣
٣	./. 7483	./. * * 1 1	./. 1441	./. * * 1 . 9	۲۵
۴	•/• 449	./.411	./.4904	./. 47.97	
-					

مقایسه ی صورت گرفته در این قسمت و تطابق نتایج به خوبی نشان می دهد که شبیه سازی صورت گرفته برای پوسته پیزوالکتریک به درستی انجام شده است. بیشینه تفاوت نتایج این بخش با مقاله ی جمال پور ۲/۲ درصد است.

۳-۱. بهینهسازی

کنترل کننده به کار رفته در این پژوهش از نوع PID است و ضرايب أن توسط الگوريتم ژنتيک چندهدفه بهينه-سازی شدهاند. توابع هدف بهینه سازی انتگرال قدر مطلق خطای جابهجایی شعاعی^{۲۰} بیبعد شده و انتگرال قدرمطلق توان الكتريكي بيبعد شده هستند كه قصد در کمینه کردن آن ها داریم. لازم به ذکر است که فرآیند بهینهسازی مقید به آن است که ولتاژ سیستم از حد تعیین شده خود فراتر نرود. از طرفی بیان این نکته اهمیت دارد که بهینهسازی برای $\infty = \gamma_s$ انجام شده است. برای بهینه سازی کنترل کننده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه استفاده شد. نتایج آخرین مرحلهی بهینهسازی در قالب جبههی پارتو^{۲۱} نشان داده شده در شکل (۴) ارائه شده است. سه نقطهی مشخص شده A، C و B به ترتیب بیانگر سیستمهای دارای شرایط کمینهی خطای جابهجایی، کمینهی توان مصرفی و نقطهی مصالحه^{۲۲} هستند. نتایج حاصل از بهینهسازی نشان

میدهد، همان گونه که انتظار میرفته، توابع هدف نسبت به هم رفتار معکوس دارند.



۲-۳. نتایج اعمال کنترل کنندهها

در این قسمت به بررسی نتایج حاصل از اعمال کنترل کنندههای انتخاب شده پرداخته می شود. در ابتدا پاسخ سیستم غیرفعال و فعال به ازای سختی برشی بی نهایت مورد بررسی قرار گرفته و در قالب شکل (۵) نشان داده شده است







غیرفعال که به ترتیب حدوداً ۱۱/۳ و ۰/۷۲ واحد هستند؛ در سیستم با کنترل کننده ی A به ترتیب به مقادیر ۶/۴ و ۰/۴۱ میرسند. همین مقادیر در سیستم با کنترل– کننده ی C به ترتیب ۱۰/۹ و ۰/۶۹ واحد و در سیستم با توجه به شکل بالا می توان نتیجه گرفت که دامنه ی جابه جایی و تنش سیستم در حضور کنترل کننده ی A حدودا نصف پوسته ی غیرفعال است به نحوی که به عنوان مثال در $x^* = \cdot$ دامنه ی جابه جایی و تنش پوسته ی

با کنترل کننده B به ترتیب برابر ۹/۱ و ۸/۵۸ واحد هستند. روند تغییرات جابه جایی و تنش نسبت به تغییر سرعت بار متحرک در پوسته های فعال و غیرفعال متفاوت است؛ به نحوی که در پوسته ی غیرفعال و پوسته ی فعال با کنترل کننده ی C دامنه ی این متغیرها با افزایش سرعت افزایش می یابد اما در پوسته با کنترل کننده ی B روند تغییرات ابتدا ثابت سپس با شیب اندک افزایشی می شود. همچنین در پوسته با کنترل –

کننده ی A متغیرها روندی کاهشی دارند. در سرعت – های پایین $(\lambda < 0.06)$ دامنه ی جابه جایی و تنش در پوسته های فعال و غیرفعال بسیار به هم نزدیک بوده و با افزایش سرعت اختلاف بین آن ها زیاد می شود. در ادامه اثر پارامتر سختی برشی بر رفتار سیستم در حضور کنترل کننده A مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در قالب شکل (۶) نمایش داده شده است.



شکل ۶.نمودار نتایج پوسته های فعال و غیرفعال برای سختی های برشی متفاوت با اعمال کنترل کنندهی A

سیستم با اعمال کنترل کننده ی A بیشترین کاهش در پاسخ را چه در جابه جایی و چه در تنش تجربه می کند. نمودارهای پاسخ مکانی حاکی از آن هستند که دامنه ی جابه جایی و تنش در محل اعمال بار ($X^* = X$) حدوداً نصف حالت غیرفعال شدهاند که با فاصله گرفتن از این نقطه خود به مرور کاهش می یابند و به مقادیر ثابت تقریباً ۱ برای W^* و ۲۰/۰ برای $\sigma_{\theta\theta}^*$ می رسند. همانطور که در نتایج مکانی دیده می شود، اختلاف بین

پاسخهای سیستم به ازای مقادیر مختلف سختی برشی در حالت غیرفعال بیشتر از اختلاف آنها پس از اعمال کنترل کنندهی A است. به عنوان مثال اختلاف بین دامنه جابهجایی در نقطه اعمال بار، به ازای سختیهای برشی صفر و بی نهایت، برای پوسته ی غیرفعال حدود ۲ واحد و برای پوسته ی فعال A حدود ۱/۱ واحد است. این اختلاف چه در پوسته ی غیرفعال و چه در پوسته با کنترل کننده ی A با فاصله گرفتن از محل اعمال بار

187

نشريهٔ علمی صوت و ارتعاش / سال دوازدهم / شمارهٔ بیست و چهار /۲۰۴۱ / سید محمود

کاهش یافته و به مرور به سمت صفر میل میکند. با افزایش سرعت بار در حالت غیرفعال مقادیر جابهجایی و تنش تا زمان رسیدن به سرعت بحرانی افزایش می-یابند اما با اعمال کنترل کننده ی A نتایج در محدوده ی مطالعه به صورت نزولی ظاهر می شوند. با بررسی دقیق تر می توان دریافت که مقدار سرعت بحرانی به

نصف مقدار اولیه کاهش یافته است که نتیجهی قابل توجهی برای دینامیک سیستم میباشد. در مرحله بعد اثر سختی برشی بر پاسخ سیستم در حضور کنترل کننده B بررسی شده که در قالب نمودارهای شکل (۲) نشان داده شده است.



با توجه به شکل می توان گفت که بیشینه میزان کاهش دامنه در زمان اعمال کنترل کننده ی B حدود ۳۰ درصد است که نسبت به پاسخهایی که در مورد پوسته با کنترل – کننده ی A دیده می شود، کمتر است. تغییر روند ایجاد شده برای نمودارهای جابه جایی – سرعت بار و تنش – شده برای نمودارهای جابه جایی – سرعت بار و تنش – سرعت بار که برای سیستم A مشاهده شده بود، برای سیستم پس از اعمال کنترل کننده ی B نیز اتفاق می افتد. اما کاملاً مشهود است که مقدار سرعت بحرانی، برخلاف زمان اعمال کنترل کننده ی A ، نسبت به حالت غیرفعال کاهش کمتری داشته و حدود سرعت

بحرانی سیستم در مقادیر بالای ۰/۳ است. اختلاف پاسخها (نسبت به تغییرات سختی برشی) در این حالت بیشتر از سیستم A است به نحوی که در نقطه اعمال بار اختلاف دامنه ی جابه جایی بین دو حالت با سختیهای برشی صفر و بینهایت حدود ۱/۳ واحد است. درنهایت نیز پاسخ سیستم در حضور کنترل کننده C و به ازای مقادیر مختلف سختی برشی بررسی شده و در قالب شکل (۸) به نمایش درآمده است.



نشريهٔ علمی صوت و ارتعاش / سال دوازدهم / شمارهٔ بیست و چهار /۲۰۶۱ / سید محمود هاشمی نژاد

غيرفعال دارد. روند تغييرات اين متغيرها نسبت به تغییرات موقعیت در پوستههای فعال و غیرفعال مشابه است. روند تغییرات نمودارهای جابهجایی و تنش بسیار مشابه یکدیگر هستند. علت این مسئله آن است که با توجه به معادلات پوسته و روند سادهسازی آن برای دستیابی به معادلات پوستهی جدار نازک حاضر، عبارت تنش سادهشده عمداً تحت تأثير متغير جابهجايي شعاعي می شود. درنتیجه این تشابه قابل انتظار بوده و مطابق با روند مدلسازی سیستم میباشد. نزدیکی پاسخ سیستم فعال در سرعتهای پایین نشاندهندهی آن است که اعمال کنترل کننده به منظور کاهش جابهجایی زمانی که سرعت بار متحرک همواره از حد مشخصی پایین تر باشد، بهصرفه نیست. همچنین با توجه به نتایج گفته شده درمی یابیم که توانایی کنترل کننده در کاهش دامنه ارتعاشات و تنش با مقدار سرعت بحرانی بار اعمالی رابطهی عکس دارد. لذا برای کاهش ارتعاشات با

سیستم کنترلکنندهی C عملکرد ضعیفی داشته و حدوداً کاهشی ۱۵ درصدی را به همراه دارد. البته باید این را نیز در نظر داشت که این تغییر کم ناشی از میزان کمتر ولتاژ اعمالی نسبت به دو کنترلکننده دیگر است. سختی برشی در این حالت بیشترین تأثیر را در میان پوسته های فعال دارد به نحوی که به عنوان مثال در نقطه اعمال بار، اختلاف دامنه جابهجایی ناشی از اختلاف سختی برشی حدود ۲ واحد (حدوداً برابر با پوسته غیرفعال) است. از سوی دیگر اعمال کنترل-کنندهی C باعث کاهش ناچیز سرعت بحرانی شده به طوری که نمودارهای جابهجایی و تنش همانند حالت غیرفعال در بازهی مورد نظر صعودی بوده و حاشیه امنی برای تغییر سرعت بار ایجاد می کند. همان طور که انتظار می رود دامنه جابه جایی و تنش سیستم به ازای کنترل کنندهی A در کمترین حالت خود است. در مقابل کنترل کننده C کمترین تغییرات را نسبت به پوستهی









روند کلی تغییرات دامنهی ولتاژ اعمالی به لایهی عملگر در سه کنترلکننده برحسب تغییرات موقعیت شکل مشابهی دارد. در هر سه مورد ولتاژ اعمالی ابتدا با شیب بالایی زیاد شده و سپس کاهشیافته و به سمت صفر $X^* = \cdot$ میل می کند. برای سیستم فعال A ولتاژ در حدود ۴/۷ واحد است که در حدود $X^* = \cdot/1$ به مقدار ۹/۳ واحد رسیده و حدوداً دو برابر می شود. از این به بعد روند ولتاژ این سیستم نزولی بوده و به سمت صفر میل $X^* > \cdot \cdot / \infty$ می کند. دامنه ی این متغیر در این حالت در Xنوسانی می شود. دامنهی نوسانات با نزدیک شدن مقدار متغیر به صفر کاهش یافته و از حدود ۲/۵ < $X^* > X^*$ ولتاژ به مقدار نهایی خود (صفر) نشست میکند. در سیستم مقدار ولتاژ بی بعد در مبدأ حدود ۱/۶ واحد است که ${
m B}$ ابتدا در روندی افزایش و در حدود $X^* = \cdot/1$ به مقدار ۴/۸ واحد رسیده و سپس افت می کند. در این حالت روند کاهشی ولتاژ شدت و شیب کمتری نسبت به حالت دارد؛ به نحوی که دامنهی ولتاژ سیستم ${
m B}$ از ۱ ${
m A}$ دامنهی C از حالت A پیشی می گیرد. در سیستم C تغییرات ولتاژ نسبت به دو مورد دیگر کمتر است. در این حالت ولتاژ در مبدأ حدود ۰/۱۲ است و سپس در روندی آرام کاهش یافته و در حدود $X^* = X$ به صفر می سد.

بررسی قرار گرفت. برای مدلسازی پوسته از تئوری كلاسيك لاو و براى مدلسازى محيط الاستيك از تئورى الاستيسيته استفاده شده است. با استفاده از تبدیل فوریه معادلات از فرم دیفرانسیلی به فرم جبری در حوزه فركانس انتقال يافته و نتايج آنها پس از حل توسط تبدیل فوریه معکوس به حوزهی زمان منتقل شدند. از روش انتگرال گیری گوسین به منظور حل تبديل فوريه معكوس استفاده شده است. نتايج حاصل از شبیه سازی های اولیه با مراجع مقایسه شد و صحت شبیه سازی به اثبات رسید. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه، تعدادی کنترلکننده بهینه برای کاهش جابهجایی پوسته و ولتاژ اعمالی طراحی شد. نتایج به ازای کنترل کننده های مختلف و همچنین سختیهای برشی مختلف بررسی و نشان داده شد که اهداف طراحی حاصل شده است. لازم به ذکر است که نوآوری این تحقیق نسبت به پژوهش های گذشته که در طول متن به آنها اشاره شد، مدفون بودن یک پوسته ی پیزوالکتریک تحت تأثیر بار متحرک و اعمال كنترل كننده بر أن مىباشد. از نتايج مهم اين مطالعه مي توان به كنترل و كاهش موفقيت آميز ارتعاشات پوستهی هوشمند مدفون با اعمال کنترلکنندههای بهینهی در نظر گرفته شده، اشاره کرد به طوری که در صورت اعمال کنترل کننده و با استفاده از لایه ی پیزوالکتریک می توان دامنه جابه جایی را تا حدود ۵۰ درصد کاهش داد. از سوی دیگر تأثیر پارامتر سختی برشی لایه ی مرزی بین پوسته و محیط الاستیک نیز بر پاسخ ارتعاشی سیستم مورد نظر بررسی شده است؛ که نتایج مذکور، همانند آنچه در بسیاری از پژوهشها دیده شده است، حاکی از آن است که دامنه ی ارتعاشات پوسته با افزایش میزان سختی برشی شعاعی کاهش می یابد. از دیگر مشاهدات مهم آن بوده است که استفاده از کنترل کنندههایی که دامنه ی ارتعاشات را به

در مورد تغییرات ولتاژ بر حسب سرعت بار متحرک قضیه شکل متفاوتی دارد. نکتهی مهم آن است که زمانی که سرعت سیستم صفر باشد تفاوتی بین ولتاژ اعمالی سه کنترل کننده مشاهده نمی شود و مقادیر هر سه حالت ۱/۲ واحد است. علت این امر آن است که در این حالت متغیرهای فیزیکی مسأله نیز مقادیر یکسانی دارند. همچنین اختلاف ولتاژهای اعمالی در سرعتهای پایین تر کمتر بوده و با افزایش سرعت این اختلاف نيز زياد مى شود. روند كلى تغييرات به اين صورت است که با افزایش سرعت بار اعمالی میزان ولتاژ اعمالی ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا میکند ولی شیب تغییرات در سه سیستم متفاوت از یکدیگر است. در سیستم A که کنترل کننده بیشترین مقدار ولتاژ اعمالی را دارد، شیب تغییرات تغییر ولتاژ در ۰/۰۲ به صفر میرسد و کمترین میزان ولتاژ اعمالی به $\lambda =$ ازای این سرعت است (حدود ۷/۰ واحد). در سرعتهای بالاتر شيب نمودار براي اين سيستم مثبت بوده و ولتاژ کاری افزایش می یاید. در مورد سیستم B نیز وضعیت مشابه است؛ با این تفاوت که شیب کاهشی اولیه نسبت $X^* = \cdot/\cdot$ ۳ به حالت A بیشتر است و ولتاژ سیستم در A بیشتر است و به حدود ۰/۴ واحد می رسد و بعد از با شیب کمتری نسبت به حالت A افزایش می یابد. در مورد پوسته ی فعال C نیز بنابر آنچه مشاهده می شود می توان گفت شیب در قسمت کاهشی بیشتر از دو مورد دیگر بود، ولی پس از آن به میزان زیادی ثابت بوده و در سرعتهای نزدیک به ۰/۳۶ دوباره شروع به افزایش مي کند.

٤. جمع بندى

در این مقاله مدلسازی و کنترل رفتار دینامیکی یک پوستهی پیزوالکتریک استوانهای مدفون در محیط الاستیک با طول بینهایت و بارگذاری متحرک مورد پوسته حساسیت کمتری نسبت تغییرات پارامتری سیستم (در اینجا سختی برشی اتصال پوسته به محیط الاستیک) دارد که نشان می دهد در حضور این لایه، مقاومت سیستم افزایش می یابد. شدت کاهش میدهند الزاماً مطلوب نیست؛ زیرا علاوه مصرف توان الکتریکی بیشتر موجب کاهش سرعت بحرانی سیستم می شوند. همچنین با توجه به نتایج دیده می شود که در حضور لایه ی پیزوالکتریک ارتعاشات

مأخذ

- Shell theory. Springer, European Mathematical Society, 2014. Encyclopedia of Mathematics. [accessed 23 February 2024] Available from: http://encyclopediaofmath.org/index.php?title=Shell_theory&oldid=33309.
- [2] Naghdi, P., On the theory of thin elastic shells. *Quarterly of applied Mathematics*, 1957, 14(4): pp.369-380.
- [3] Love, Augustus Edward Hough. "XVI. The small free vibrations and deformation of a thin elastic shell." *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. (A.)* 179, 1888, pp.491-546.
- [4] Payton, R., Dynamic membrane stresses in a circular elastic shell. 1961.
- [5] Ruzzene, M. and A.M. Baz. Dynamic stability of periodic shells with moving loads. in Smart Structures and Materials 2001: Smart Structures and Integrated Systems. 2001. SPIE.
- [6] Zhang, J.D., B. Zhen, and X. Li, The Critical Velocity for an Infinite Cylindrical Shell under a Moving Load. *Applied Mechanics and Materials*, 2014, 441: pp.461-464.
- [7] Lee, S. and J. Seok, Dynamic analysis of a hollow cylinder subject to a dual traveling force imposed on its inner surface. *Journal of Sound and Vibration*, 2015, 340: pp.283-302.
- [8] Arazm, M., H. Eipakchi, and M. Ghannad, Vibrational behavior investigation of axially functionally graded cylindrical shells under moving pressure. *Acta Mechanica*, 2019, 230: pp.3221-3234.
- [9] Eipakchi, H., F.M. Nasrekani, and S. Ahmadi, An analytical approach for the vibration behavior of viscoelastic cylindrical shells under internal moving pressure. *Acta Mechanica*, 2020, 231: pp.3405-3418.
- [10] Huo, H., et al., Exact benchmark solutions of random vibration responses for thin-walled orthotropic cylindrical shells. *International Journal of Mechanical Sciences*, 2021, 207: pp.106644.
- [11] Saeedi, Soheil, Mohsen Kholdi, Abbas Loghman, Hossein Ashrafi, and Mohammad Arefi. "Thermo-elasto-plastic analysis of thick-walled cylinder made of functionally graded materials using successive approximation method." *International Journal of Pressure Vessels and Piping*", 194, 2021, 104481.
- [12] Gao, X.-L., Critical velocities of a two-layer composite tube under a moving internal pressure. Acta Mechanica, 2023, 234(5): pp.2021-2043.
- [13] Chonan, S., Dynamic response of a cylindrical shell imperfectly bonded to a surrounding continuum of infinite extent. *Journal of Sound and Vibration*, 1981, 78(2): pp.257-267.
- [14] Dwivedi, J., V. Singh, and P. Upadhyay, Nonaxisymmetric dynamic response of imperfectly bonded buried fluid-filled orthotropic cylindrical shells. 1996.

- [15] Hasheminejad ,S.M. and M. Komeili, Effect of imperfect bonding on axisymmetric elastodynamic response of a lined circular tunnel in poroelastic soil due to a moving ring load. *International Journal of Solids and Structures*, 2009, 46(2): pp.398-411.
- [16] Yuan, Z., et al., Dynamic response of a tunnel buried in a saturated poroelastic soil layer to a moving point load. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2015, 77: pp.348-359.
- [17] Alzabeebee, S.I.A., Enhanced design approaches for rigid and flexible buried pipes using advanced numerical modelling. 2017, University of Birmingham.
- [18] Akbarov, S., M. Mehdiyev, and M. Ozisik, Three-dimensional dynamics of the moving load acting on the interior of the hollow cylinder surrounded by the elastic medium. *Structural Engineering and Mechanics*, 2018, 67(2): pp.185-206.
- [19] Akbarov, S.D. and M.A. Mehdiyev, 3D dynamics of the oscillating-moving load acting in the interior of the hollow cylinder surrounded with elastic medium. *Structural Engineering and Mechanics*, 2019, 71(6): pp.713-738.
- [20] Tong, L., et al., Dynamic effect of a moving ring load on a cylindrical structure embedded in poroelastic space based on nonlocal Biot theory. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2020, 128: p.105897.
- [21] Liu, Y., Z. Qin, and F. Chu, Nonlinear dynamic responses of sandwich functionally graded porous cylindrical shells embedded in elastic media under 1: 1 internal resonance. *Applied Mathematics* and Mechanics, 2021, 42(6): pp.805-818.
- [22] Alibeigloo, A., M. Talebitooti, Three-dimensional transient coupled thermoelasticity analysis of FGM cylindrical panel embedded in piezoelectric layers. *Mechanics of Smart Structures*, 2021.
- [23] Girnis, S., et al. Action of Moving Load on a Two-Layer Shell in Elastic Medium. in International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry "Interagromash"". 2022. Springer.
- [24] Singh, V., P. Upadhyay, and B. Kishor, On the dynamic response of buried orthotropic cylindrical shells under moving load. *International journal of mechanical sciences*, 1988, 30(6): pp.397-406.
- [25] Saviz, M., M. Shakeri, and M. Yas, Three-dimensional elasticity analysis of a laminated cylindrical shell with piezoelectric layer under dynamic loads. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science*, 2007, 221(12): pp.1507-1519.
- [26] Zhang, Y., S. Xie, and X. Zhang, Vibration control of a simply supported cylindrical shell using a laminated piezoelectric actuator. *Acta Mechanica*, 2008, 196(1): pp.87-101.
- [27] Sheng, G. and X. Wang, Response and control of functionally graded laminated piezoelectric shells under thermal shock and moving loadings. *Composite Structures*, 2010, 93(1): pp.132-141.
- [28] Zhang, S., R. Schmidt, and X. Qin, Active vibration control of piezoelectric bonded smart structures using PID algorithm. *Chinese journal of aeronautics*, 2015, 28(1): pp.305-313.
- [29] Arefi, M., R. Karroubi, and M. Irani-Rahaghi, Free vibration analysis of functionally graded laminated sandwich cylindrical shells integrated with piezoelectric layer. *Applied Mathematics and Mechanics*, 2016, 37: pp.821-834.
- [30] Zhou, Y., J. Zhu, and D. Liu, Dynamic analysis of laminated piezoelectric cylindrical shells. *Engineering Structures*, 2020, 209: p. 109945.
- [31] Liu, J., et al., Deformation of laminated and sandwich cylindrical shell with covered or embedded piezoelectric layers under compression and electrical loading. *Composite Structures*, 2020, 240: p. 112041.
- [32] Lee, S.-L., Active vibration suppression of wind turbine blades integrated with piezoelectric sensors. *Science and Engineering of Composite Materials*, 2021, 28(1): pp.402-414.

- [33] Li, C., P. Li, and X. Miao, Research on nonlinear vibration control of laminated cylindrical shells with discontinuous piezoelectric layer. *Nonlinear Dynamics*, 2021, 104(4), pp.3247-3267.
- [34] Acharya, R., et al., Structural response of a low-fill box culvert under static and traffic loading. *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 2016, 30(1): p. 04014184.
- [35] Forrest, J. and H. Hunt, A three-dimensional tunnel model for calculation of train-induced ground vibration. *Journal of sound and vibration*, 2006, 294(4-5): pp.678-705.
- [36] Rahimi, G., M. Arefi, and M. Khoshgoftar, Application and analysis of functionally graded piezoelectrical rotating cylinder as mechanical sensor subjected to pressure and thermal loads. *Applied Mathematics and Mechanics*, 2011, 32: pp.997-1008.
- [37] Mohammadi, M., et al., Higher-order thermo-elastic analysis of FG-CNTRC cylindrical vessels surrounded by a Pasternak foundation. *Nanomaterials*, 2019, 9(1): p. 79.
- [38] Visioli, Antonio. Practical PID control. Springer Science & Business Media, 2006.
- [39] Sathe, M.P., et al., Speed Control of DC Motor using PID Controller-A Review, 2019.
- [40] Dubey, V., H. Goud, and P.C. Sharma, Role of PID control techniques in process control system: a review. Data Engineering for Smart Systems: Proceedings of SSIC 2021, 2022: pp.659-670.
- [41] Abdennour, A. and F.A. Alturki, A Comparative Study of PI/PID Classical and Intelligent Tuning Methods. *Journal of Engineering and Computer Sciences*, 2008, 1(1): pp.29-42.
- [42] Hasheminejad, S.M. and A. Jamalpoor, Control of sound transmission into a hybrid double-wall sandwich cylindrical shell. *Journal of Vibration and Control*, 2022, 28(5-6): pp.689-706.
- [43] Ke, L., Y. Wang ,and J. Reddy, Thermo-electro-mechanical vibration of size-dependent piezoelectric cylindrical nanoshells under various boundary conditions. *Composite Structures*, 2014, 116: pp.626-636.
- [44] Lu, J.-F., et al., Response of a circular tunnel embedded in saturated soil to a series of equidistant moving loads. *Acta Mechanica*, 2017. 228: pp.3675-3693.
- [45] Steele, C., Beams and shells with moving loads. *International Journal of Solids and Structures*, 1971, 7(9): pp.1171-1198.
- [46] Lu, Jian-Fei, and Dong-Sheng Jeng. "Dynamic response of a circular tunnel embedded in a saturated poroelastic medium due to a moving load." 2006, pp.750-756.
- [47] Hwang, W.-S., H.C. Park, and W. Hwang, Vibration control of a laminated plate with piezoelectric sensor/actuator: finite element formulation and modal analysis. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, 1993, 4(3): pp.317-329.
- [48] Kheibari, Forough, and Yaghoub Tadi Beni. "Size dependent electro-mechanical vibration of single-walled piezoelectric nanotubes using thin shell model." *Materials & Design*, 114, 2017, pp.572-583.
- [49] Wang, Y.Q., Y.F. Liu, and J.W. Zu, Analytical treatment of nonlocal vibration of multilayer functionally graded piezoelectric nanoscale shells incorporating thermal and electrical effect. The European Physical Journal Plus, 134, 2019, pp.1-15.

پيوست الف

براساس تئوری جدار نازک لاو، مؤلفههای جابهجایی سه
بعدی پوسته PZT مربوطه به ترتیب با جابهجاییهای
سطح میانی مرتبط در جهات
$$x, \theta$$
 و شعاعی از طریق
روابط کلاسیک مرتبط هستند.[۴۳]
 $\overline{u}(x, \theta, z, t) = u(x, \theta, t) - z \frac{\partial w(x, \theta, t)}{\partial x}$
 $\overline{v}(x, \theta, z, t) = v(x, \theta, t) - z \frac{\partial w(x, \theta, t)}{\partial \theta}$
 $\overline{w}(x, \theta, z, t) = w(x, \theta, t)$

همچنین، روابط کرنش-جابهجایی مربوطه در پوستهی الاستیک و لایههای پوستهی PZT از طریق روابط زیر بدست می آیند.

$$\begin{split} \varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x} - z \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ \varepsilon_{\theta\theta} &= \frac{1}{r_c} \left(\frac{\partial v}{\partial \theta} + w - \frac{z}{r_c} \frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2} - \frac{z}{r_c} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \\ \varepsilon_{x\theta} &= \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{1}{r_c} \frac{\partial u}{\partial \theta} - 2 \frac{z}{r_c} \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial \theta} - \frac{z}{r_c} \frac{\partial v}{\partial x} \quad (1 - \omega) \\ \text{Implies the set of the set$$

$$\mathbf{σ}_{c} = \mathbf{Q}_{c} \boldsymbol{\varepsilon}_{c}$$

$$\mathbf{σ}_{i}^{p} = \mathbf{Q}_{p} \boldsymbol{\varepsilon}_{c} - \mathbf{e} \mathbf{E}_{i}, \quad \mathbf{D}_{i} = \mathbf{e}^{T} \boldsymbol{\varepsilon}_{c} + \boldsymbol{\mu} \mathbf{E}_{i} \qquad (\textbf{\textbf{(I-i)}})$$

$$\text{ the decoupled of the equation of the equaterises of the equation o$$

$$\Phi_{s} = -\cos\left\{\frac{\pi}{h_{p}}\left(z - \frac{2h_{2} + h_{p}}{2}\right)\right\}\varphi_{s}\left(x, \theta, t\right)$$

$$\begin{split} \Phi_{a} &= -\cos\left\{\frac{\pi}{h_{p}}\left(z + \frac{2h_{2} + h_{p}}{2}\right)\right\}\varphi_{a}\left(x,\theta,t\right) & \text{and} \\ &+ \frac{2}{h_{p}}\left(z + \frac{2h_{2} + h_{p}}{2}\right)V_{a}\left(x,\theta,t\right) & \text{cs} \\ & \text{if} \\ & \text{if} \\ & \text{if} \\ & \text{of} \\ & \text{stars} \\ & \text{stars$$

للاوه بر این، ماتریس ضرایب پوسته ی الاستیک و لایه های پیزوالکتریک، Q_{c,p} ماتریس کاهشیافته کوپلینگ الکترومکانیکی ، e، ماتریس گذردهی دی الکتریک کاهش یافته، μ، به صورت زیر تعریف می شوند:

$$\mathbf{Q}_{c} = \begin{bmatrix} \frac{E_{2}}{(1-\nu_{2}^{2})} & \frac{\nu_{2}E_{2}}{(1-\nu_{2}^{2})} & 0 \\ \frac{\nu_{2}E_{2}}{(1-\nu_{2}^{2})} & \frac{E_{2}}{(1-\nu_{2}^{2})} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{E_{2}}{2(1+\nu_{2})} \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{Q}_{p} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & 0 \\ c_{12} & c_{22} & 0 \\ 0 & 0 & c_{66} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{e} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & e_{31} \\ 0 & 0 & e_{32} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \mu_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \mu_{33} \end{bmatrix}$$

(الف-۵)

همچنین، پارامترهای پیزوالکتریک کاهش یافته نیز به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} c_{11} &= \tilde{c}_{11} - \frac{\tilde{c}_{13}^2}{\tilde{c}_{33}} \quad c_{12} &= \tilde{c}_{12} - \frac{\tilde{c}_{13}^2}{\tilde{c}_{33}} \quad c_{22} &= \tilde{c}_{22} - \frac{\tilde{c}_{23}^2}{\tilde{c}_{33}} \\ c_{66} &= \tilde{c}_{66} \quad e_{31} &= \tilde{e}_{31} - \frac{\tilde{c}_{13}^2 \tilde{e}_{33}}{\tilde{c}_{33}} \quad e_{32} &= \tilde{e}_{32} - \frac{\tilde{c}_{23}^2 \tilde{e}_{33}}{\tilde{c}_{33}} \\ \mu_{11} &= \tilde{\mu}_{11} \quad \mu_{22} &= \tilde{\mu}_{22} \quad \mu_{33} &= \tilde{\mu}_{33} - \frac{\tilde{e}_{33}^2}{\tilde{c}_{33}} \\ (\forall - u u) \end{aligned}$$

اکنون، تغییرات انرژی کرنش، انرژی جنبشی و کار نیروهای غیر پایستار برای پوسته استوانه ای ساندویچی پیزوالکتریک را می توان به صورت زیر نوشت: $\delta \prod_{f} = \int_{A} \left(p_{2}^{T} + p_{2}^{R} \right) \delta w dA - \int_{A} p_{3}^{T} \, \delta w dA$

$$(a_{11}, d_{11}) = \int_{-h_p - h_2}^{-h_2} (1, z^2) c_{11} dz + \int_{h_2}^{h_p + h_2} (1, z^2) c_{11} dz + \int_{-h_2}^{h_2} \frac{E_c(1, z^2)}{1 - v_c^2} dz (a_{12}, d_{12}) = \int_{-h_p - h_2}^{-h_2} (1, z^2) c_{12} dz + \int_{h_2}^{h_p + h_2} (1, z^2) c_{12} dz + \int_{-h_2}^{h_2} \frac{v_c E_c(1, z^2)}{1 - v_c^2} dz (a_{22}, d_{22}) = \int_{-h_p - h_2}^{-h_2} (1, z^2) c_{22} dz + \int_{h_2}^{h_p + h_2} (1, z^2) c_{22} dz + \int_{-h_2}^{h_2} \frac{E_c(1, z^2)}{1 - v_c^2} dz (a_{66}, d_{66}) = \int_{-h_p - h_2}^{-h_2} (1, z^2) c_{66} dz + \int_{h_2}^{h_p + h_2} (1, z^2) c_{66} dz + \int_{-h_2}^{h_2} \frac{E_c(1, z^2)}{2(1 + v_c)} dz (E_{31}^a, E_{32}^a) = \int_{-h_p - h_2}^{-h_2} (e_{31}, e_{32}) \left(\frac{\pi z}{h_p}\right) \sin\left[\frac{\pi}{h_p} \left(z + \frac{2h_2 + h_p}{2}\right)\right] dz.$$

$$\begin{split} X_{11}^{a} &= \int_{-h_{p}-h_{2}}^{-h_{2}} \mu_{11} \left\{ \cos \left[\frac{\pi}{h_{p}} \left(z + \frac{2h_{2} + h_{p}}{2} \right) \right] \right\}^{2} dz \\ X_{22}^{a} &= \int_{-h_{p}-h_{2}}^{-h_{2}} \mu_{22} \left\{ \frac{1}{r_{c} + z} \cos \left[\frac{\pi}{h_{p}} \left(z + \frac{2h_{2} + h_{p}}{2} \right) \right] \right\}^{2} dz \\ X_{33}^{a} &= \int_{-h_{p}-h_{2}}^{-h_{2}} \mu_{33} \left\{ \frac{\pi}{h_{p}} \sin \left[\frac{\pi}{h_{p}} \left(z + \frac{2h_{2} + h_{p}}{2} \right) \right] \right\}^{2} dz \\ X_{11}^{s} &= \int_{-h_{p}-h_{2}}^{-h_{2}} \mu_{11} \left\{ \cos \left[\frac{\pi}{h_{p}} \left(z - \frac{2h_{2} + h_{p}}{2} \right) \right] \right\}^{2} dz \\ X_{22}^{s} &= \int_{-h_{p}-h_{2}}^{-h_{2}} \mu_{22} \left\{ \frac{1}{r_{c} + z} \cos \left[\frac{\pi}{h_{p}} \left(z - \frac{2h_{2} + h_{p}}{2} \right) \right] \right\}^{2} dz \\ X_{33}^{s} &= \int_{-h_{p}-h_{2}}^{-h_{2}} \mu_{33} \left\{ \frac{\pi}{h_{p}} \sin \left[\frac{\pi}{h_{p}} \left(z - \frac{2h_{2} + h_{p}}{2} \right) \right] \right\}^{2} dz \\ I_{1} &= \int_{-h_{p}-h_{2}}^{-h_{2}} \rho_{p} dz + \int_{-h_{2}}^{h_{2}} \rho_{2} dz + \int_{h_{2}}^{h_{p}+h_{2}} \rho_{p} dz \end{split}$$

$$\begin{split} \delta \prod_{s} &= \int_{A} \int_{-h_{p}-h_{2}}^{-h_{2}} \left(\boldsymbol{\sigma}_{a}^{p} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{c} - \mathbf{D}_{a} \delta \mathbf{E}_{a} \right) dz \, dA \\ &+ \int_{A} \int_{-h_{p}-h_{2}}^{-h_{2}} \boldsymbol{\sigma}_{c} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{c} dz \, dA \\ &+ \int_{A} \int_{h_{2}}^{h_{p}+h_{2}} \left(\boldsymbol{\sigma}_{s}^{p} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{c} - \mathbf{D}_{s} \delta \mathbf{E}_{s} \right) dz \, dA \\ \delta \prod_{K} &= \int_{A} \int_{-h_{p}-h_{2}}^{-h_{2}} \rho_{p} \left(\dot{u} \delta \dot{u} + \dot{v} \delta \dot{v} + \dot{w} \delta \dot{w} \right) dz \, dA \\ &+ \int_{A} \int_{-h_{2}}^{h_{2}} \rho_{2} \left(\dot{u} \delta \dot{u} + \dot{v} \delta \dot{v} + \dot{w} \delta \dot{w} \right) dz \, dA \\ &+ \int_{A} \int_{h_{2}}^{h_{p}+h_{2}} \rho_{p} \left(\dot{u} \delta \dot{u} + \dot{v} \delta \dot{v} + \dot{w} \delta \dot{w} \right) dz \, dA \end{split}$$

در این مرحله، با استفاده از روابط انرژی ها (الف-۷) با توجه به معادلات تنش (الف-۲) و روابط الکتریکی (الف-۳) مربوط به پیزوالکتریک در اصل همیلتون ، پس از انتگرال گیری در ابعاد زمان و مکان، در نهایت به سیستم معادلات دینامیکی دست مییابیم. معادلات حرکت برای پوسته استوانه ای ساندویچی معادلات حرکت برای پوسته استوانه ای ساندویچی المائه شده است که در آن پارامترهای ارائه شده است که در آن پارامترهای

پىنوشت

- 1. Love thin shell theory
- 2. Love-Kirchhoff assumptions
- 3. Donnell-Moshtari theory
- 4. Frobenius method
- 5. Discrete Analytical Method (DAM)
- 6. Successive Approximation Method (SAM)
- 7. Perfect bonded
- 8. Navier's equation
- 9. Biot theory
- 10. Euler-Bernoulli
- 11. Winkler-Pasternak foundation
- 12. Lord-Shulman theory
- 13. Functionally Graded Piezoelectric Material (FGPM)
- 14. Proportional-Integral-Derivative
- 15. First-order Shear Deformation Theory (FSDT)
- 16. Hamilton's principle
- 17. wave propagation matrix
- 18. Integral of absolute error (IAE)
- 19. Mathematica
- 20. Integral of absolute radial displacement error
- 21. pareto front
- 22. trade-off